

MEMORIAS

Solo lectura

ROM

Se programan en el proceso de fabricación. Son baratas y se usan para el firmware.

PROM

Son programadas por el usuario una vez. Usan tecnología CMOS. Son baratas y están formadas por una malla de fusibles.

EPROM

Cuando se programan, se escriben eléctricamente y se borran con luz ultravioleta que pasa a través de un cristal de cuarzo.

EEPROM

Pueden ser borradas y escritas eléctricamente. Sus celdas tienen estructura SAMOS, proveniente de la FAMOS.

Son memorias que se escriben una vez, y en ausencia de electricidad, no pierden datos.

Lectura/escritura

SRAM

Conocidas como memoria caché, son caras, voluminosas y están construidas a base de biestables.

DRAM

RAM dinámica, es más barata, no necesita de refresco, aunque es más lenta y precisa de transistores.

FPM

Memoria desfasada. Señal RAS indicadora de fila, y señal CAS para la búsqueda del dato.

EDO

Predecesoras de las BEDO. Paredias a las FPM pero pueden iniciar el acceso a memoria sin haber obtenido la salida anterior.

SDRAM

Memorias DRAM sincronas, gran velocidad del bus de datos.

DDR SDRAM

Double Data Rate SDRAM, la velocidad física y efectiva se ve duplicada. El bus es de 64 bits, precisan de menor voltaje para su funcionamiento.

RDRAM

Tecnología propietaria, velocidades desde 400-800MHz. Líneas de datos en paralelo reducidas.

XDR/XDR2/DRAM

Ancho de banda de 16-32 bits, velocidades de hasta 7.2GHz

MRAM/PRAM/Z-RAM

magnetorresistiva/de cambio de fase/RAM

Son memorias en las que se puede leer y escribir, pero cuando la corriente cesa, se pierden los datos contenidos en ellas.